

Invenția se referă la domeniul tehnicii radioelectronice și poate fi utilizată la obținerea heterostructurilor cu straturi subțiri de compuși binari $A^{II}B^{VI}$ pentru producerea fotorezistoarelor și a fotoconvertoarelor.

Sunt cunoscute procedee de obținere a straturilor subțiri monocristaline și policristaline de compuși binari $A^{II}B^{VI}$ prin evaporare în vid a materialelor din evaporatoare în prezența unui gradient de temperatură dintre evaporator și substrat [1].

Cea mai apropiată soluție este procedeul de obținere a straturilor subțiri de compuși binari $A^{II}B^{VI}$ [2]. Depunerea straturilor se efectuează prin disocierea materialului inițial în atomi separați la existența unui gradient de temperatură dintre evaporator și substrat cu depunerea ulterioară pe substraturi.

Însă procedeul cunoscut nu asigură o creștere esențială a parametrilor ce caracterizează heterostructura dată.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în majorarea parametrilor electrici și fotoelectrici ai heterostructurii cu straturi subțiri și elaborarea noii tehnologii de obținere a heterostructurilor.

Esența invenției constă în aceea că procedeul de obținere a heterostructurilor cu straturi subțiri pe baza compușilor binari $A^{II}B^{VI}$ include depunerea pe un substrat în vid a unui strat de compuși cu bandă îngustă, cu tratarea lui termică și chimică ulterioară și a unui strat de compuși cu bandă largă, în prezența gradientului de temperatură dintre evaporator și substrat, totodată stratul de compuși cu bandă îngustă este depus prin metoda evaporării în volumul cuaziînchis, iar stratul de compuși cu bandă largă prin evaporare discretă.

Procedeul poate fi utilizat și la obținerea heterostructurii-test, procedând în mod invers.

Rezultatul procedurii conform invenției constă în majorarea parametrilor ce caracterizează heterostructura, și anume a curentului și tensiunii, pe baza alierii straturilor componente ale heterostructurii date.

Așadar, are loc o creștere a curentului ce trece prin heterostructură și totodată o majorare a tensiunii; doi parametri esențiali ce caracterizează structura obținută cu straturi subțiri, cu o prelucrare a stratului cu bandă îngustă.

Majorarea curentului se datorează faptului că la depunerea stratului cu bandă largă prin metoda evaporării discrete are loc micșorarea rezistenței specifice a stratului și micșorarea barierei de potențial dintre componentele heterostructurii.

Invenția se explică cu ajutorul figurilor, care reprezintă:

- fig. 1, structura-test a heterostructurii cu straturi subțiri (ITO-ZnTe-CdSe-IN) și (ITO-CdSe-ZnTe-Ag);
- fig. 2, dependența curentului de scurtcircuit și tensiunii de circuit deschis de intensitatea iluminării;
- fig. 3, dependența distribuției spectrale a heterostructurii.

Exemplu de realizare a procedurii de obținere a heterostructurilor cu straturi subțiri pe substrat de sticlă

În calitate de substrat pentru formarea heterostructurii cu straturi subțiri servește o plăcuță de sticlă cu un strat transparent de oxid de indiu (ITO, $In_2O_3+SnO_3$). Aria suprafeței este de

4 cm^2 . În primul rând, dacă se obține heterostructura de tip I (ITO-ZnTe-CdSe-In), se depune prin evaporare discretă stratul cu bandă largă cu o suprafață de $1,5 \dots 1,8 \text{ cm}^2$ de grosimea $3 \dots 4 \text{ }\mu\text{m}$ timp de 10-15 min, apoi se depune stratul cu bandă îngustă prin metoda volumului cuaziînchis cu o grosime de $5 \dots 8 \text{ }\mu\text{m}$ pe o suprafață de $1,5 \text{ cm}^2$ timp de 15 min. După aceasta toată structura obținută se cufundă în soluție suprasaturată de $CdCl_2$ timp de 30...40 min, apoi se tratează termic la o temperatură de $360 \dots 380^\circ\text{C}$ timp de 30 min.

Pentru structura de tip II (ITO-CdSe-ZnTe-Ag) se procedează în felul următor: se depune stratul cu bandă îngustă prin metoda volumului cuaziînchis, stratul este supus tratamentului descris mai sus, apoi se depune prin metoda evaporării discrete stratul cu bandă largă. Prin evaporare termică se depun contacte pentru structura de tip I și de tip II, In și Ag respectiv. Ca rezultat s-a obținut heterostructura ilustrată în fig. 1.

Din fig. 2 se observă că curentul de scurtcircuit atinge valoarea de $7 \dots 8 \text{ mA/cm}^2$, iar tensiunea de circuit deschis are valoarea de $0,6 \dots 0,75 \text{ V}$.

Din fig. 3 se observă că se lărgiște regiunea spectrală a heterostructurii date, unde ambele componente contribuie la majorarea curentului pe o unitate de centimetru. Domeniul de distribuție este cuprins în limitele $560 \dots 900 \text{ nm}$.

Heterostructurile se obțin prin depunerea stratului cu bandă largă folosind metoda evaporării discrete și depunerea stratului cu bandă îngustă prin metoda volumului cuaziînchis, unde stratul de bandă îngustă este supus unui tratament special. Acest procedeu permite de a obține heterostructuri cu următorii parametri principali:

$I_{sc} = 7,2 \text{ mA/cm}^2$, $U_{cd} = 0,6-0,75 \text{ V}$, pentru întreg spectrul optic vizibil.

Heterostructurile obținute pot fi utilizate în radioelectronică la obținerea aparatelor optoelectronice, cât și la fabricarea fotoreceptoarelor într-un domeniu larg al spectrului vizibil.